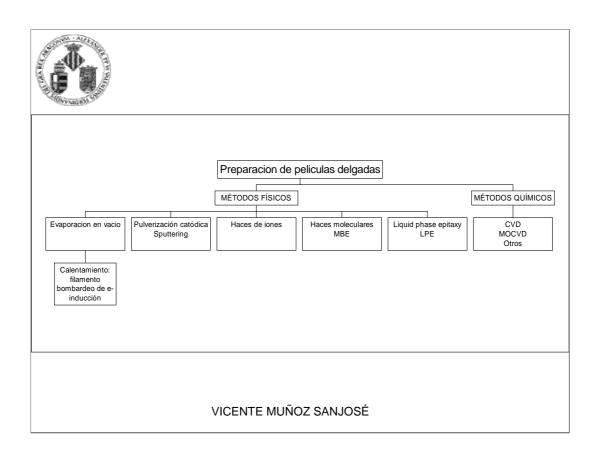


Tecnología de Materiales

Métodos de obtención de capas delgadas





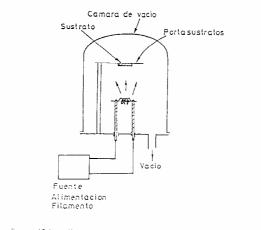
Evaporación en vacío

Vacío≈ 10 Torr



Presión de vapor

Velocidad ≈ 100 Å/s



Il gota 12.18. Esquema de un sistema de evaporación por filamento.



Deposición en vacío

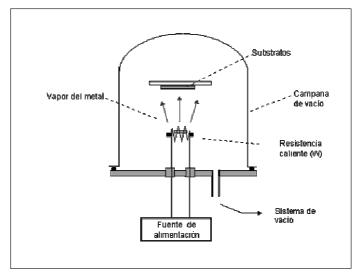




Evaporación en vacio filamento incandescente

Filamento de: Wolframio, Tántalo, Tungsteno

Problema: Posible contaminación por el filamento





Evaporación por bombardeo de electrones

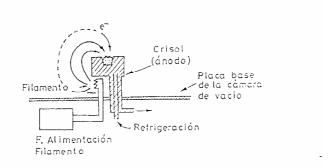
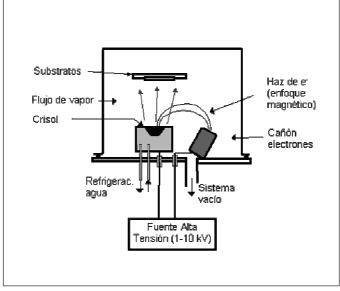


Figura 12.19. Esquema de un sistema de evaporación por bombardeo de electrones



Evaporación por bombardeo de electrones





Calentamiento por inducción

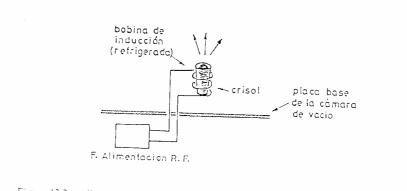
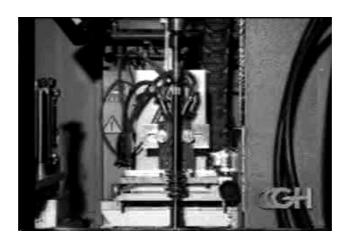


Figura 12.20. Esquena de un sistema de evaporación mediante calentamiento por inducci-



Calentamiento por inducción



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Pulverización catódica (Sputtering)

Presión 10 mTorr Gas inerte (Argón) Bombardeo por iones

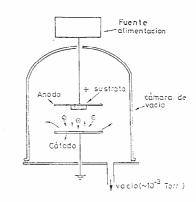


Figura 12.21. Esquema del proceso de descarga entre dos electredos, para productr un efecto de bombardeo sobre el cátodo (esputiering-e-



Pulverización catódica tipo magnetrón

Confinamiento de la descarga: Aumento de la corriente

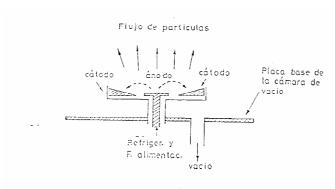
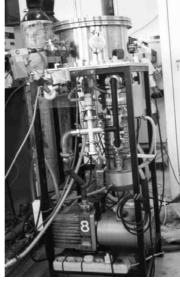


Figura 12.22. Esquerra de la geometría de los electrodos en un sistema de «sputtering» tipo magnetrón.



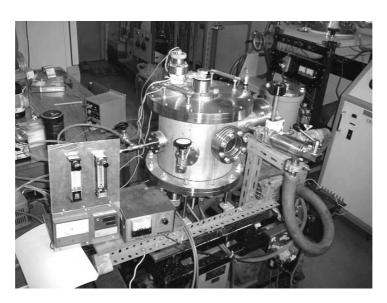
Equipo para la pulverización catódica (Sputtering)



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Equipo de Sputtering



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Haces de Iones

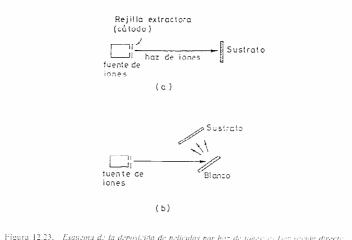


Figura 12.23. Esquema de la deposición de películas por haz de tones: a) Trepesación directa.
b) Deposición indirecta.



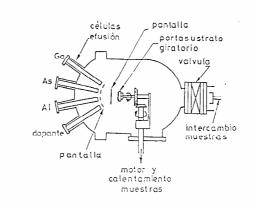
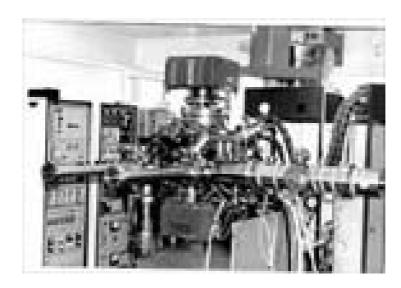


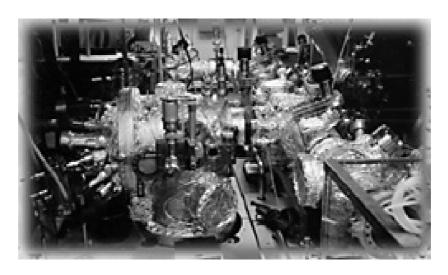
Figura 12.24. Esquema de una instalación de crecimiento de películas delgada m epitaxia de haces meliculares (MBE).





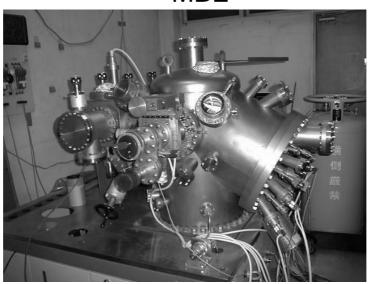
VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ





VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ





VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Liquid phase epitaxy LPE

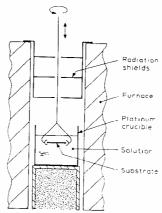
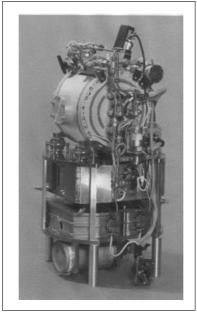


Figure 7.10 Apparatus for LPE growth of rare-earth iron garnets by horizontal dipping. Note that the substrate is rotated to give stirring similar to that found in Czochralski systems. A review of the process used is given by Čermák and Nevřiva (1984).



LPE apparatus



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Liquid phase epitaxy LPE

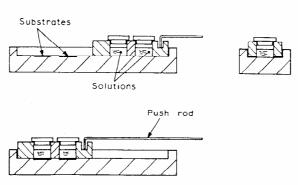


Figure 7.11 Apparatus for LPE growth of compound semiconductors by the sliding boat method. The upper diagrams give side and end elevations before and after growth. The lower diagram is the situation during growth. Wood and Hager (1983) describe the use of the process for $Cd_xHg_{1-x}Te$, and Shaw (1983) gives a computer model of this process.



Liquid Phase Epitaxy



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Chemical vapour deposition

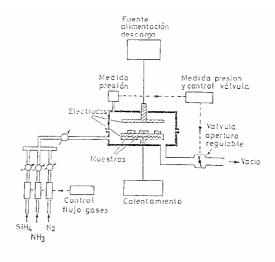


Figura 12.25. Esquema de un sistema de crecimiento de películas de Si₂N₃ mediante la técnica de CVD, asistida con un plasma.



Chemical Vapour Deposition



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



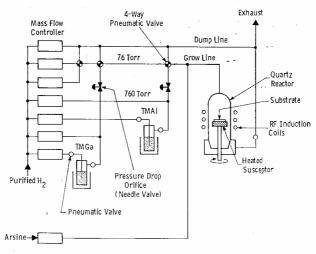
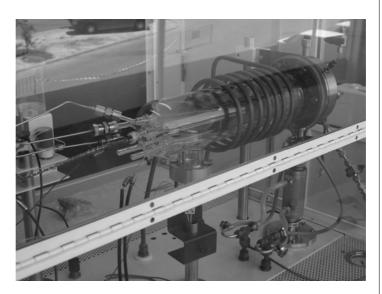


Fig. 3. Low pressure MOCVD system with individual pressure control on each bubbler.



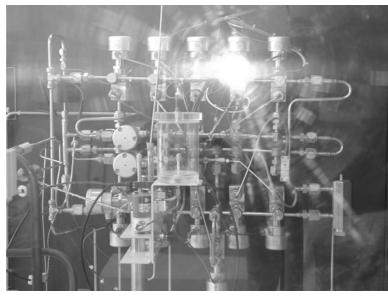
Reactor



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Mixer Gas-gates



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



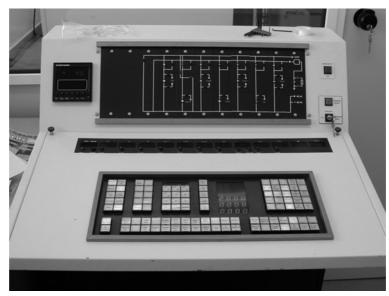
Control Y Sistema



VICENTE MUÑOZ SANJOSÉ



Control





Spectrometer

